# Design Study on a Short-Period Hybrid Staggered Array Undulator by Use of High-Tc Superconductor Bulk Magnets

Ryota Kinjo<sup>1,A)</sup>, Toshiteru Kii<sup>A)</sup>, Heishun Zen<sup>A)</sup>, Keisuke Higashimura<sup>A)</sup>, Kai Masuda<sup>A)</sup>, Kazunobu Nagasaki<sup>A)</sup>, Hideaki Ohgaki<sup>A)</sup>, Young Uk Jeong<sup>B)</sup> <sup>A)</sup> Institute of Advanced Energy, Kyoto University Inst. Advanced Energy, Kyoto Univ. Gokasho, Uji, Kyoto, 611-0011 <sup>B)</sup> Korea Atomic Energy Research Institute

#### Abstract

A hybrid staggered undulator by use of high-Tc superconducting bulk magnets has been investigated in Institute of Advanced Energy, Kyoto University. In this report, we show the results of magnetic field calculation. The new undulator can achieve K = 1 at the period of 8 mm when it consists of vanadium permendur poles and the superconducting magnets with its critical current density of  $5 \times 10^8 \text{ A/m}^2$ . This indicates a possibility of short-period undulator. We also show the experimental setup of magnetic field measurements in 3-periods prototype.

# 高温超伝導バルク磁石を用いた 短周期のハイブリッドスタガードアンジュレータの検討

#### 1. はじめに

京都大学エネルギー理工学研究所では、短周期ア ンジュレータの候補として、バルク高温超伝導体磁 石を用いたハイブリッドスタガードアンジュレータ について研究を行っている[1]。

バルク高温超伝導体磁石とは、不純物や欠陥を持 つ第二種超伝導体中での磁束のピン止め効果を利用 した磁石で、従来の永久磁石より1桁大きい磁場を 持つ。現在では中心での表面磁束密度が17Tを超え る試料が作られている[2]。ただし、バルク高温超伝 導体を磁石として使用するためには超伝導転移温度 以下に冷却し着磁する必要がある。アンジュレータ に超伝導コイルではなくバルクの超伝導体を利用し ようという試みは現在までも行われてきているが、 その着磁方法が主要な課題となっている[3],[4]。

スタガードアレイアンジュレータでは、交互にス タックされた強磁性体と非磁性体によってソレノイ ド磁場を歪め、アンジュレータ磁場を作り出す[5]。 ハイブリッドスタガードアンジュレータは、スタ ガードアレイアンジュレータの非磁性体をソレノイ ド磁場と逆方向の磁化を持つ永久磁石で置き換える ことにより、スタガードアレイアンジュレータの弱 点である低いアンジュレータ磁場を改善するもので、 K値が約40%上昇するという計算結果が報告されて いる[6]。

バルク高温超伝導体磁石を用いたハイブリッドス タガードアンジュレータ(図1)は、磁石の磁化方 向が単一方向でよいというハイブリッドスタガード 構造の利点によってバルク高温超伝導体磁石の着磁 方法の問題を解決し、永久磁石よりさらに強力な磁 石で非磁性体を置き換えることにより、永久磁石を 利用した通常のハイブリッドスタガードアンジュ レータより高いK値を得ることが期待できる。それ ゆえ短周期のアンジュレータになる可能性がある。

本研究では、バルク高温超伝導体磁石を用いたハ イブリッドスタガードアンジュレータの特性と短周 期化の可能性を調べるため、バルク高温超伝導体磁 石の特徴的な磁場分布および静磁場計算コード Radiaを用いてアンジュレータ磁場の計算を行った。



#### 2. 静磁場計算

バルク高温超伝導体磁石を用いたハイブリッドス タガードアンジュレータの磁場計算を、表1に示す

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: r-kinjo@iae.kyoto-u.ac.jp

パラメータを用いてRadiaで行った。 Radiaは European Synchrotron Radiation Facilityで開発された 磁場計算コードである。臨界電流モデルによるとバ ルク高温超伝導体に捕捉できる表面磁束密度は、超 伝導臨界電流密度J<sub>2</sub>およびバルク体のサイズによっ て決まる。超伝導材料の精力的な研究によって希土 類、バリウム、銅酸化物からなるバルク高温超伝導 体において数Tの磁場中で1×10<sup>10</sup>A/m<sup>2</sup> (4.2K)、 5×10<sup>8</sup>A/m<sup>2</sup> (63K)もの臨界電流密度を持つ材料がつ くられている[7]。本研究においては液体窒素の融点 (63K)付近で得られる5×10<sup>8</sup>A/m<sup>2</sup>以下の臨界電流密度 を仮定して計算を行った。

図2に、ソレノイド磁場に対するアンジュレータ 磁場の依存性を示す。また図3に、それぞれの磁石 の強さでの、ソレノイド磁場によって変えることの できるK値の範囲を示す。K値は電子ビームの蛇行 を特徴付けるパラメータで、アンジュレータ光の波 長をλ、ローレンツファクターをγとすると、

 $\lambda = \lambda_{\mu} \left( 1 + K^2 / 2 \right) / (2\gamma^2)$ 

の関係がある。アンジュレータとして主に使われる K値1付近となるアンジュレータ磁場が発生できてい る。またソレノイド磁場によってK値を変えること ができるというスタガードアレイアンジュレータの 特徴も持っていることがわかった。

図4に、同じ周期とギャップ3.6mmの永久磁石型 アンジュレータのデータと比較した。点がバルク高 温超伝導体磁石を用いたハイブリッドスタガードア

表1:計算パラメータ

周期, $\lambda_{\mathrm{u}}$	4 - 16	mm
ギャップ, $g_{\mathrm{u}}$	4	$\rm mm$
周期数, N	20	
磁石の大きさ	(40, 20, 2-8)	$\mathbf{m}\mathbf{m}$
強磁性体の大きさ	磁石と同じ	
臨界電流密度, $J_{\rm c}$	$< 1 \times 10^9$	$A/m^2$
ソレノイド磁場, $B_{ m s}$	0 - 20	Т





図2:ソレノイド磁場依存性

ンジュレータ、黒い破線がSPring8で開発された永 久磁石を真空中に並べ狭いギャップを実現した真空 封止型アンジュレータ、赤い実線が永久磁石を冷却



図3:ソレノイド磁場で可変なK値の範囲



図4:永久磁石アンジュレータとの比較



図5:短周期化に必要な臨界電流密度

することで飽和磁化および保持力を上昇させる CPMU (Cryogenic Permanent Magnet Undulator) であ る[8]。 $2\times10^8$ A/m<sup>2</sup>の臨界電流密度があればこれら永 久磁石型アンジュレータより強いアンジュレータ磁 場を発生させることができるという結果を得た。

図5に、周期とその周期でK=1を達成するために 必要な臨界電流密度J<sub>c</sub>との関係を示す。5×10<sup>8</sup>A/m<sup>2</sup>で 周期8mmという短周期を得る。



図6:試作機

## 3. 試作機の製作状況

前章でバルク高温超伝導磁石を用いたハイブリッ ドスタガードアンジュレータの静磁場計算結果をも とに短周期化の可能性を示した。計算ではバルク高 温超伝導体磁石の磁場分布は臨界電流モデルにもと づき幾何的な中心部分で最大値を取り、磁場勾配が 臨界電流密度で一意に決まるようなモデルを用いた。 しかしながら、ハイブリッドスタガード構造におい てバルク高温超伝導体磁石を着磁する場合に、周囲 のバルク高温超伝導体との相互作用や、強磁性体の 影響により、単体で着磁した場合と異なった磁場分 布になると考えられる。また逆磁場を印加すること により、バルク高温超伝導体磁石内の磁化が変化す ると考えられる。そのような影響は計算には含まれ ていない。そこで現在、計算では無視したこれらの 影響を調べるために、バルク高温超伝導体磁石を用 いたハイブリッドスタガードアンジュレータの試作 機を開発中である。

図6に試作機の概略図と写真を示す。真空ダクト の内側に、バルク高温超伝導体である厚さ2.5mm、 直径25mmの半円形のDyBaCuOが銅のポールによっ て固定されている。真空ダクトは外壁と内壁の間に 液体窒素を流せる構造になっており、内壁と銅の ポールとの接触によりバルク体を冷却する。バルク の温度は内壁に設置された温度計によって計測する。 真空ダクトの内壁は真空断熱され、外壁にはグラス ウールがまかれている。その外側に0.05Tのソレノ イドコイルが設置されている。また直線導入器の先 端には極低温用のホールプローブが固定されている。 着磁方法は以下のとおりである。外部からソレノ イド磁場を印加した状態で、バルク体を液体窒素に よって超伝導臨界温度(約91K)以下まで冷やす。 するとソレノイド磁場を消しても磁場がバルク内に ピン止めされた状態となる。これをフィールドクー リングという。

試作機で行う実験については次のとおりである。 まず強磁性体を挟まずバルクのみを並べた場合にバ ルク同士の相互作用によりバルクの着磁分布がどの ように変化するかを調べる。次に強磁性体をはさん だ場合についてバルクの着磁分布がどのように変化 するか調べる。着磁したバルク高温超伝導体磁石に よってできるアンジュレータ磁場を直線導入器の先 につけた極低温用ホールプローブで計測する。

# 4. まとめ

バルク高温超伝導体磁石を用いたハイブリッドス タガードアンジュレータは、ソレノイドによる一方 向の磁場で着磁ができるため着磁に機械的機構が必 要なく、ソレノイド磁場によりアンジュレータ磁場 を変更でき、永久磁石アンジュレータより強いアン ジュレータ磁場を発生でき、短周期アンジュレータ の候補となりうることを磁場計算の結果をもとに報 告した。

また、試作機の製作状況を報告した。予定してい る着磁試験の、フィールドクーリングの方法、バル ク高温超伝導体磁石のみを並べた場合の計測、強磁 性体を挟んだ場合の計測について述べた。

## 参考文献

- T. Kii, et al., "Design Study on High-Tc Superconducting Micro Undulator", Proceedings of FEL 2006 pp. 653-655, 2006.
- [2] M. Tomita, et al., "High-Temperature Superconductor Bulk Magnets That Can Trap Magnetic Fields of over 17 Tesla at 29K", Nature vol. 421 pp. 517-520, 2003.
- [3] T. Tanaka, et al., "Application of High-Temperature Superconducting Permanent Magnets to Synchrotron Radiation Sources", Physical Review ST-AB7, 090704 (2004), 2004.
- [4] T. Tanaka, et al., "Pure-type Superconducting Permanent-Magnet Undulator", Journal of Synchrotron Radiation (2005). 12, pp. 442-447, 2005.
- [5] S. Sasaki, "The Possibility for a Short-Period Hybrid Staggered Undulator", Proceedings of 2005 Particle Accelerator Conference (2005) pp. 982-984, 2005.
- [6] Y.C. Huang, et al., "Compact Far-IR FEL Design", Proceedings of the Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A318 (1992) 765-771, 1992
- [7] M. Morita, et al., "Development of Oxide Superconductors High Tc Bulk Superconductor, QMG, and Its Magnetic Applications", Nippon Steel Technical Report No.93 January 2006 pp. 18-23, 2006.
- [8] T. Hara, et al., "Insertion Devices of Next Generation", Proceedings of APAC 2004 pp. 216-220, 2004.